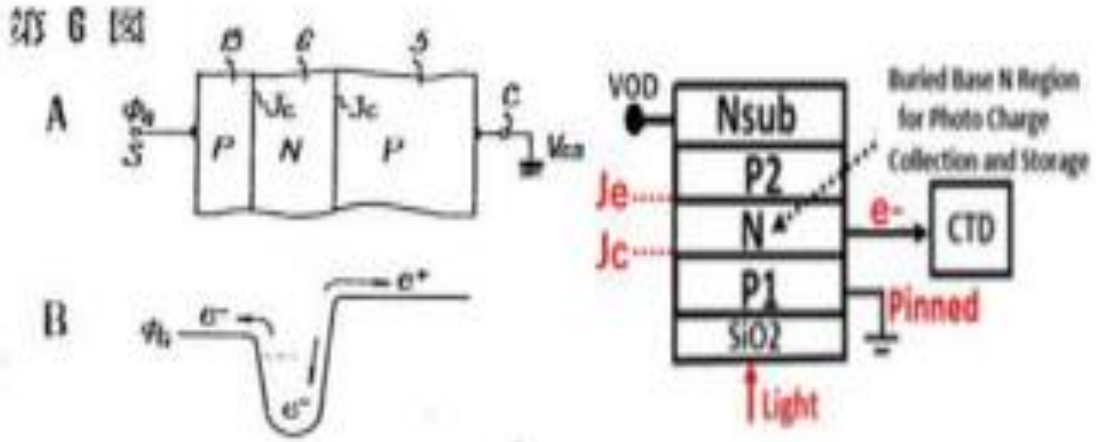
III. Origin Of Pinned Buried Photodiode

Pinned Buried Photodiode shown in Figure 6 in JPA1975-134985 filed on November 10, 1975



Pinned Buried Photodiode invented by Yoshiaki Hagiwara as defined in Japanese Patent Claim of JPA1975-127647 filed on October 23, 1975

特許請求の範囲

半導体基体の一方の主面側に、絶縁膜を介して電荷転送用電極が複数配列される1の導電型の転送領域が形成され、之より上記半導体基体の他方の主面側に上記転送領域に接する他の導電型の領域と該領域に接する1の導電型の領域とより成る受光領域が形成され、上記転送用電極に所要の電圧を印加することにより、上記受光領域に蓄積した電荷を上記転送領域に転送し、上記電荷転送用電極に上記所要の電圧とは異るクロック電圧を印加して上記基体の上記一方の主面に沿つて電荷の転送を行うようにしたことを特徴とする固体撮像装置。

Pinned Buried Photodiode shown in Figure 7 in JPA1975-127647 filed on October 23, 1975

Fig 7 A reproduction of Patent Claim and a figure in JPA1975-134985